

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 10, 2018

Определение энантиоморфного избытка в поликристаллических металлических образцах со структурой типа В20 <i>Н. М. Чубова, В. А. Дядькин, С. В. Григорьев</i>	3
Безмасочная рентгеновская литография на основе МОЭМС и микрофокусных рентгеновских трубок <i>Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало, Н. А. Дюжев</i>	10
Микроструктурные эффекты при электронно-микроскопических исследованиях карбонатных пород <i>В. А. Кузьмин</i>	21
Развитие методов стыковки полей экспонирования при использовании электронно-лучевой литографии на примере брэгг-френелевских линз для рентгеновского излучения <i>М. А. Князев, А. А. Свинцов, Р. Р. Фахртдинов</i>	26
Параллели и взаимосвязанные закономерности в изменениях объемных и поверхностных свойств систем $\text{CdV}^{\text{VI}}-\text{CdTe}$ <i>И. А. Кировская, П. Е. Нор, Т. Л. Букашкина</i>	30
Морфология и структура высокодисперсного композита на основе бемита, полученного из водных растворов Na-KMn с порошком алюминия <i>Н. М. Антонова, Ф. М. Болдырев, И. Ю. Забияка</i>	37
Плазменное напыление наноструктурного покрытия на основе оксида гафния с использованием течения Прандтля–Майера <i>С. В. Савушкина, М. Н. Полянский, Г. В. Панасова</i>	45
Механизм влияния гамма-облучения на поверхностные свойства политетрафторэтилена <i>А. Ю. Обвинцев, С. А. Серов, Н. В. Садовская, С. А. Хатинов, В. М. Бузник</i>	52
Исследование методами наведенного тока и катодolumинесценции влияния облучения электронным пучком на дефектную структуру латерально заросших пленок GaN <i>П. С. Вергелес, Е. Б. Якимов</i>	59
Оценка максимальной концентрации неравновесных носителей заряда в GaN при облучении электронным пучком <i>Е. Б. Якимов</i>	66
Анализ эмиссионных характеристик полевых катодов на основе регрессионных моделей <i>Н. В. Егоров, А. Ю. Антонов, М. И. Вараюнь</i>	72
Влияние углеродной модификации поверхности на автоэмиссионные свойства кристаллов кремния <i>Р. К. Яфаров, А. В. Смирнов, А. Р. Яфаров</i>	80
Влияние радиационных дефектов, созданных низкоэнергетическими протонами в сильнолегированном слое, на характеристики кремниевых n^+-p-p^+ -структур <i>Ю. А. Агафонов, Н. М. Богатов, Л. Р. Григорьян, В. И. Зиненко, А. И. Коваленко, М. С. Коваленко, Ф. А. Колоколов</i>	86
Электрическая активность ступеней поверхности сапфира как кристалла-подложки для эпитаксии <i>В. П. Власов, В. М. Каневский, А. В. Бутахин, А. Э. Муслимов</i>	92
Влияние предварительного облучения мощным тепловым потоком на реэмиссию и термодесорбцию имплантированного дейтерия из малоактивируемых сталей <i>С. А. Рябцев, Ю. М. Гаспарян, О. В. Огородникова, З. Р. Арутюнян, Н. С. Климов, А. Г. Посакалов, А. А. Писарев</i>	96
Стенд для изучения воздействия протонного облучения на микросхемы: оценка потоков частиц, активации и мощности дозы <i>С. А. Гаврилов, Л. Н. Латышева, С. Г. Лебедев, Н. М. Соболевский, А. В. Фещенко</i>	102
Исследование двухкоординатного газоразрядного детектора медленных нейтронов с твердотельным конвертером из бора-10 <i>С. И. Поташев, Ю. М. Бурмистров, А. И. Драчев, С. Х. Караевский, Г. В. Солодухов</i>	108